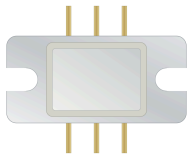
13600–14500 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

LCI-PA-13600-14500-PS41MIN · 13600–14500 MHz · GaN Amplificador de potencia encapsulado.



Valores de la tabla RF: PSAT ≥ 41 dBm; Ganancia de potencia ≥ 20 dB; PAE 37 % (típico). Condiciones de ensayo RF: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW.

CMW010B

Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensiones del encapsulado: 18.03 × 8.7 mm.

Características RF

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	13600	-	14500	MHz
Potencia de salida saturada	-	41	-	-	dBm
Ganancia de potencia	-	20	-	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	-	32	37	-	%
Planitud de la ganancia de potencia	-	-	0.5	1	dB

Polarización DC y corrientes

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión de drenador	-	-	-	-	28	V
Tensión de puerta	-	-	-	-	-3.05	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	-	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	-	-5	-	-	V
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Potencia de entrada máxima	-	-	-	24	dBm

Dimensiones del encapsulado

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del encapsulado	18.03 × 8.7	mm
Distancia total entre terminales	14.7	mm

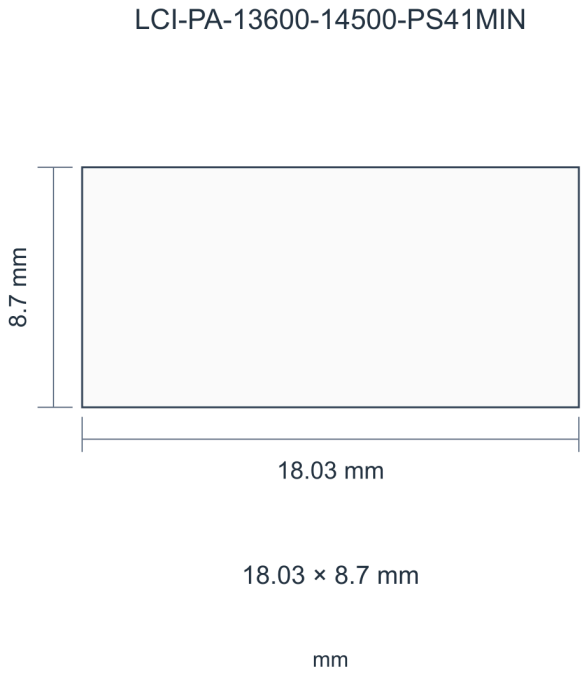
Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Notas de integración

CMW010B Aplicar primero la polarización de puerta y después la de drenador. Al apagar, retirar primero la de drenador. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Plano dimensional mecánico

Plano parcial con cotas confirmadas en mm. Para el montaje, consulte el plano completo de instalación.

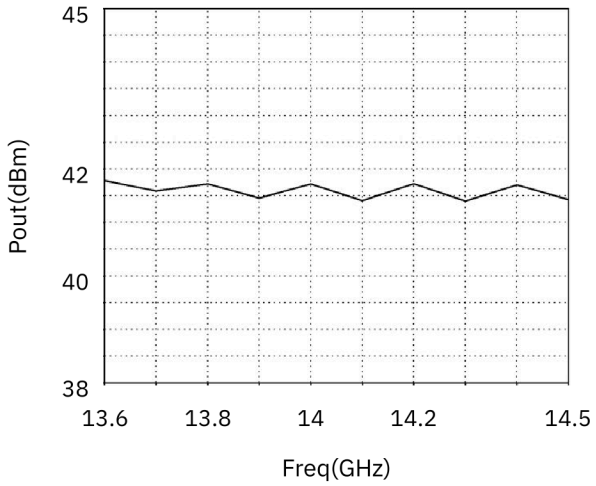


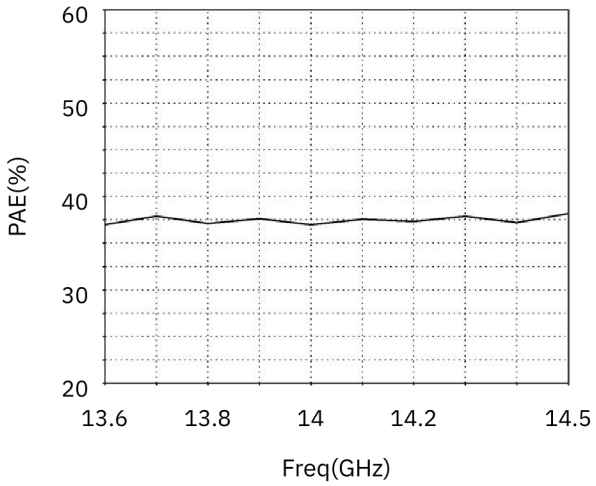
Curvas de rendimiento

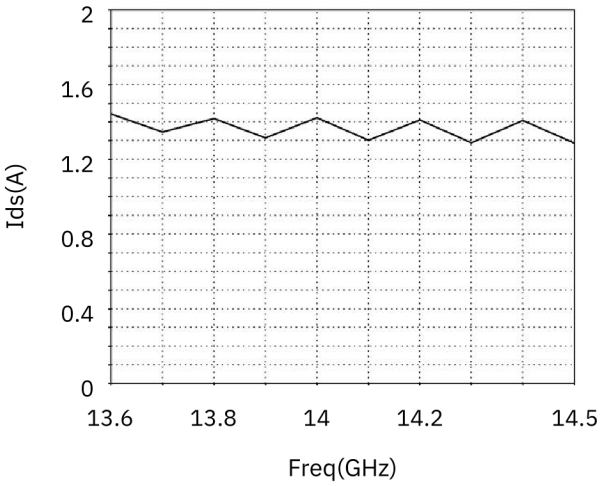
Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

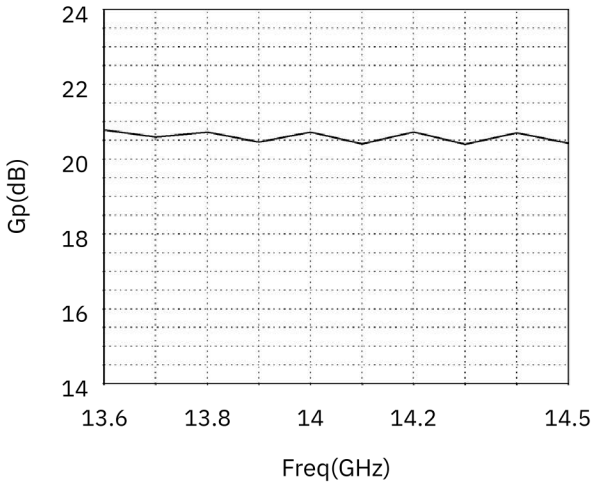
Onda continua (CW) — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Ganancia de potencia.

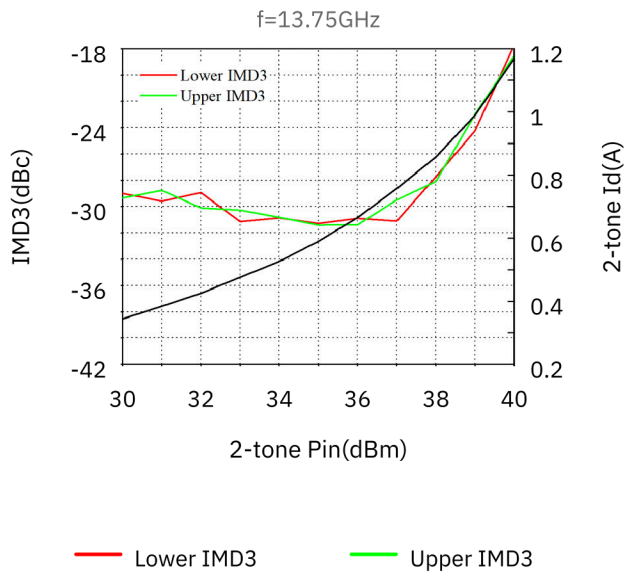
Notas de la figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-3.05V; Pin=21dBm.

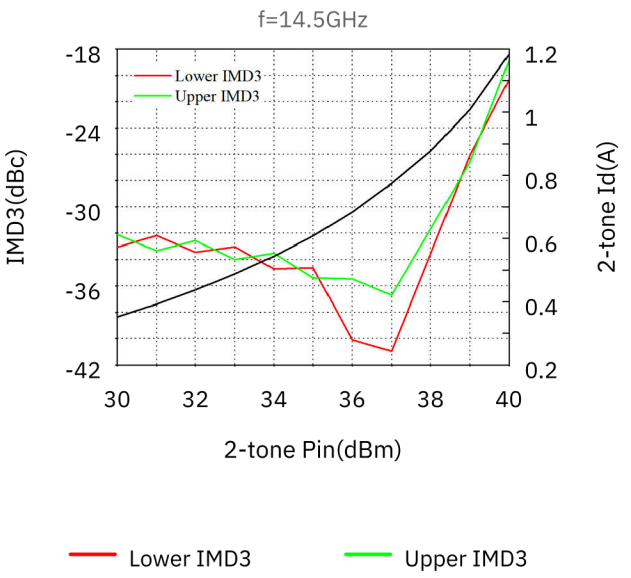


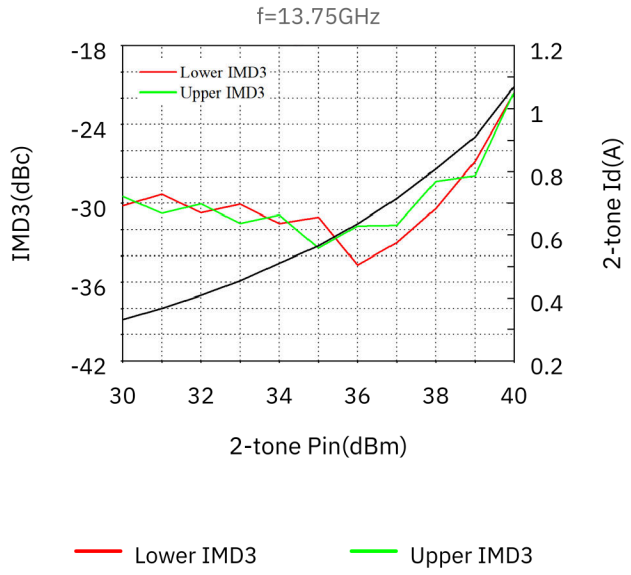


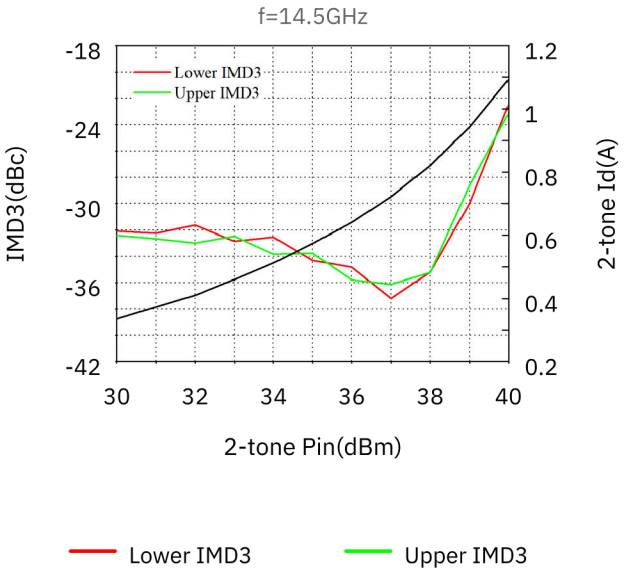












IMD3(dBc); Id(A). f = 13.75/14.5 GHz; Δf = 10 MHz; ID = 200 mA; C = 100 nF (1–2), 200 nF (3–4); Pin de dos tonos=30...40 dBm.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.